

一般整流ダイオード

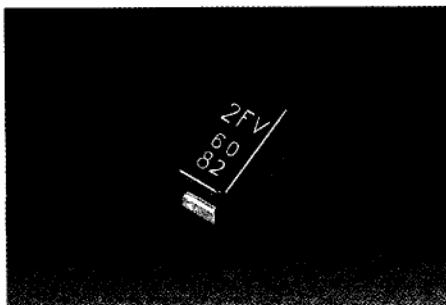
Rectifier Diode

单体型 Single Diode

SHINDENGEN ELECTRIC MFG 54E D ■ 8219387 0000687 726 ■ SHEJ

D2F□

600V 1.4A

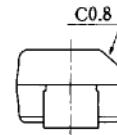
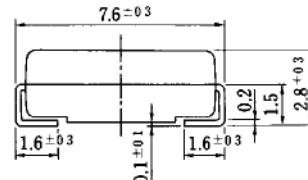
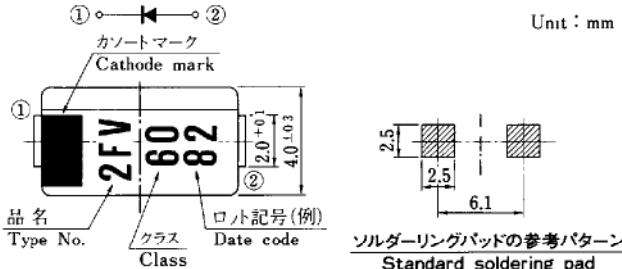


■ 外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS

Case : 2F Type

T-01-15

Unit : mm



■ 定格表 RATINGS

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D2F10	D2F20	D2F40	D2F60	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-55~150				°C
接合部温度 Operating Junction Temperature	Tj			150				°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			100	200	400	600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, T _a =25°C 50Hz sine wave, R-load, T _a =25°C	アルミナ基板実装 On alumina substrate プリント基板実装 On glass-epoxi substrate	1.4				A
せん頭サーボ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, T _j =25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, T _j =25°C		1.1				
				60				A

電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (T_f=25°C)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F =1.4, パルス測定 I _f =1.4A, Pulse measurement	MAX 1.05	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R =V _{RM} , パルス測定 V _r =V _{RM} , Pulse measurement	MAX 10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jl}	接合部・リード間 Junction to lead	MAX 24	°C/W
	θ _{ja}	接合部・周囲間 Junction to ambient	MAX 90 MAX 120	
		アルミナ基板実装 On alumina substrate プリント基板実装 On glass-epoxi substrate		

■ 特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS

